

日程表 (会場別) 1

筑波大学

会場名	収容人数	3月30日(月)		3月31日(火)		4月1日(水)		4月2日(木)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
3A棟	A 2F-3A202	180	「超伝導分科会企画「超伝導」使える技術から使われる技術へ」	5.1 半導体レーザー・発光 / 受光素子	「人材育成・男女共同参画委員会企画「イノベーション研究推進のための人材育成」	12.3 電子機能材料・デバイス (ショート口頭講演)	16. 非晶質・微結晶分科内総合講演「有機・無機ハイブリッド材料の最前線」 16.1 基礎物性・評価	5.3 光制御	5.3 光制御	
	B 2F-3A203	128	5.3 光制御	「不透明な時代を切り拓く分極反転光デバイス」	5.3 光制御	宅間賞受賞記念講演 5.3 光制御	5.3 光制御	5.3 光制御	5.3 光制御	
	C 2F-3A204	315	12.10 特定テーマ: 生体分子計測・バイオナノテクノロジー	「有機分子・バイオエレクトロニクス分科会企画「マイクロ・ナノ粒子を用いた機能設計」	12.9 有機トランジスタ (ショート口頭講演)	日本光学会総会, 光学論文賞授賞式・記念講演	12.9 有機トランジスタ	12.9 有機トランジスタ	12.9 有機トランジスタ	
	D 2F-3A207	94	「半導体プロセス・デバイス・回路のモデリングとシミュレーション」		「X線・中性子による埋もれた界面研究の最前線」		7.5 ビーム・光励起表面反応	「Si系およびC系ナノ構造と励起プロセス」	15.7 エピタキシーの基礎	
	E 2F-3A209	94		15.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶	9.4 熱電変換	9.4 熱電変換	15.1 バルク結晶成長	15.1 バルク結晶成長	15.8 結晶評価, ナノ不純物・結晶欠陥	15.8 結晶評価, ナノ不純物・結晶欠陥
	F 3F-3A301	120	15.6 IV 族系化合物	15.6 IV 族系化合物	12.10 特定テーマ: 生体分子計測・バイオナノテクノロジー	12.10 特定テーマ: 生体分子計測・バイオナノテクノロジー	11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用	11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用	11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長	
	G 3F-3A304	144		「エネルギー・環境研究会企画「光合成に学ぶエネルギーデバイス」の展望」	15.6 IV 族系化合物	「半導体計測・評価技術(2)-最先端プロセスの要求と計測評価技術の可能性を掘り下げる」	5.1 半導体レーザー・発光 / 受光素子	5.1 半導体レーザー・発光 / 受光素子	5.1 半導体レーザー・発光 / 受光素子	5.1 半導体レーザー・発光 / 受光素子
	H 3F-3A306	124		「フォトニックICT研究会企画「フォトニックICTを支える最先端のシステム, サブシステム, デバイス技術」		「表面プラズモン放射フォトニクス」	3.8 近接場光学	3.8 近接場光学	3.3 機器・デバイス光学	3.3 機器・デバイス光学
	J 3F-3A308	111		15.2 II-VI 族結晶	15.3 III-V 族エピタキシャル結晶	15.3 III-V 族エピタキシャル結晶	15.3 III-V 族エピタキシャル結晶	15.3 III-V 族エピタキシャル結晶	15.3 III-V 族エピタキシャル結晶	15.3 III-V 族エピタキシャル結晶
	K 3F-3A312	111	7.4 ナノインプリント	7.4 ナノインプリント	3.4 計測光学	「光波センシング技術研究会企画「光ファイバーセンサーの新展開」	3.4 計測光学	3.4 計測光学		
	L 4F-3A402	202	8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野	「プラズマが拓く次世代医療・バイオ技術～プロセス・材料・デバイス応用の最先端～」	業績受賞記念講演 / 宮崎昭宣氏 10.2 スピンデバイス・回路・計測技術	「Japan-Korea session: Progresses in the Spin-RAM Domain wall new devices and Spintronics」	12.4 光機能材料・デバイス	「ナノ・マイクロ構造を利用した効率的なエネルギー変換」	「ランダム系フォトエレクトロニクス研究会企画「ランダム系物質の発光と誘導放射」	
	M 4F-3A403	202		スクール「会社に入る前に身につけておいてほしいこと-企業における技術者像-」	12.8 有機EL	特別シンポ「応用物理との接点を求めて」	スクール「安価、簡単、便利～大気圧プラズマの基礎と応用～」			
	N 4F-3A405	77	17.1 応用物理一般	17.1 応用物理一般	17.1 応用物理一般		17.3 新技術	17.4 トライボロジー 17.5 エネルギー変換・貯蔵	17.6 資源・環境	
	Q 4F-3A409	104	10.1 新物質創生・物性探索 (ショート口頭講演)	10.3 磁気記録媒体・磁気センサー	8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野	8. プラズマエレクトロニクス分科内招待講演 8.5 プラズマナノテクノロジー	10.1 新物質創生・物性探索 (ショート口頭講演)	10.4 光・量子スピントロニクス		
S 4F-3A416	124		13.3 絶縁膜技術	13.3 絶縁膜技術	13.3 絶縁膜技術	13.2 半導体表面	13.2 半導体表面			
3L棟	T 2F-3L201	121	13.5 Si プロセス技術	13.5 Si プロセス技術	13.5 Si プロセス技術	13.5 Si プロセス技術	13.5 Si プロセス技術	8.1 プラズマ生成・制御	8.1 プラズマ生成・制御	
	V 2F-3L202	101	13.6 Si デバイス/集積化技術	13.6 Si デバイス/集積化技術	13.7 シミュレーション	「日本真空協会企画「環境問題に貢献する/貢献するための真空技術」	13.6 Si デバイス/集積化技術	13.6 Si デバイス/集積化技術	13.6 Si デバイス/集積化技術	
理科系修士棟	W 1F-B107	97	7.6 イオンビーム一般	7.6 イオンビーム一般	12.1 作製技術	12.4 光機能材料・デバイス	12.1 作製技術	12.1 作製技術	12.1 作製技術	
	X 1F-C103	168	12.8 有機EL	12.8 有機EL	6.4 薄膜新材料	「創発によるビルドアップ型ナノ物質創製-非平衡科学に基づく材料開発を目指して-」	7.7 微小電子源 (ショート口頭講演)	「ナノCMOSへの新展開-高機能化・高性能化を図る新材料・新構造技術」		
総合研究棟B	ZA 1F-総合B0112	100		12.2 評価・基礎物性	12.2 評価・基礎物性	12.2 評価・基礎物性	14.1 探索的材料物性	14.1 探索的材料物性	14.1 探索的材料物性	
	ZB 1F-総合B0110	123	14.2 超薄膜・量子ナノ構造	業績受賞記念講演 / 榎 裕之氏 14.2 超薄膜・量子ナノ構造	14.2 超薄膜・量子ナノ構造	14. 半導体B(探索的材料・物性・デバイス)分科内招待講演 14.2 超薄膜・量子ナノ構造	11.1 基礎物性	11.1 基礎物性	11.1 基礎物性	
2B棟	ZC 4F-2B406	89	1.2 放射線発生装置・理工学応用 1.3 放射線応用・新技術		1.3 放射線応用・新技術	「放射線分科会企画「高性能シンチレーション検出器への期待と開発動向」	1.1 放射線物理一般・検出器基礎	1.1 放射線物理一般・検出器基礎	1.1 放射線物理一般・検出器基礎	
	ZD 4F-2B409	87		17.7 磁場応用		「磁場応用研究グループ企画「磁場発生技術の現状と応用-永久磁石から超強磁場まで-」	12.6 高分子・ソフトマテリアル	12.5 液晶	12.5 液晶	
	ZE 4F-2B411	200	3.8 近接場光学	「ナノフォトニクスにおけるナノ加工の最前線と理論基盤」	12.3 電子機能材料・デバイス (ショート口頭講演)	「効率10%を越える有機太陽電池を目指して」		APEX/JJAP フレンドシップミーティング		

日程表 (会場別) 2

筑波大学

会場名	収容人数	3月30日(月)		3月31日(火)		4月1日(水)		4月2日(木)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
2B棟	ZF 4F-2B412	200	12.3 電子機能材料・デバイス (ショート口頭講演)	「多元系機能材料研究会企画「カルコパイロイト系材料の高いポテンシャル - 基礎物性と応用展開 -」	14.4 超高速・機能デバイス	14.4 超高速・機能デバイス	13.4 配線技術	13. 半導体 A (シリコン) 分科内総合講演「今後のLSI配線における金属材料技術」		
	ZG 5F-2B507	120	14.3 プロセス技術・界面制御	14.3 プロセス技術・界面制御	13.4 配線技術	13.4 配線技術	4.7 レーザー・プロセッシング	4.7 レーザー・プロセッシング	4.7 レーザー・プロセッシング	
	ZH 5F-2B508	120	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	
2H棟	ZJ 1F-2H101	344	15.4 III-V 族窒化物結晶 (ショート口頭講演)	15.4 III-V 族窒化物結晶 (ショート口頭講演)	15.4 III-V 族窒化物結晶 (ショート口頭講演)	15.4 III-V 族窒化物結晶 (ショート口頭講演)	15.4 III-V 族窒化物結晶 (ショート口頭講演)	15.4 III-V 族窒化物結晶 (ショート口頭講演)	合同セッション K「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	合同セッション K「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」
	ZK 2F-2H201	344	合同セッション K「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	「ワイドギャップ酸化物半導体の進展と今後の展望」	合同セッション K「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	合同セッション K「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	合同セッション K「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	合同セッション K「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	合同セッション K「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」	合同セッション K「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」
総合棟 A 棟 共用棟 A	ZL 1F-総合 A110	104	12.7 生物・医用工学・バイオチップ	林賞受賞記念講演 12.7 生物・医用工学・バイオチップ	12.7 生物・医用工学・バイオチップ	12.7 生物・医用工学・バイオチップ	12.7 生物・医用工学・バイオチップ	4.1 量子光学・原子光学		
	ZM 1F-共 A101	120		4.6 レーザー分光応用・計測	宅間賞受賞記念講演 4.4 超高速・高強度レーザー	4.4 超高速・高強度レーザー	4.4 超高速・高強度レーザー	4.4 超高速・高強度レーザー		
	ZN 2F-共 A201	120	4.2 フォトリソグラフィ	4.2 フォトリソグラフィ	4.2 フォトリソグラフィ	4.2 フォトリソグラフィ	4.2 フォトリソグラフィ	4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料
1B棟	ZQ 2F-1B208	80	2.2 精密計測・ナノ計測 (ショート口頭講演)	2.3 計測標準	2.1 計測・制御技術	2.1 計測・制御技術	11.5 接合、回路作製プロセスおよびデバイス応用	9.3 ナノエレクトロニクス	9.3 ナノエレクトロニクス	
	ZR 3F-1B308	80	7.1 X線技術	7.1 X線技術	7.2 電子顕微鏡、評価、測定、分析	7.8 ビーム応用一般・新技術	7.3 リソグラフィ	7.3 リソグラフィ		
1C棟	ZT 2F-1C210	120	3.1 物理光学・光学基礎	「偏光計測の基礎と応用最前線」	8.3 プラズマ成膜・表面処理 (ショート口頭講演)	「シリコン LED の実現に向けた新しいアプローチ」	13.3 絶縁膜技術	「ポストスケール時代をデバイス・物性物理から斬る - これが半導体デバイスの未来像だ -」	13.3 絶縁膜技術	13.3 絶縁膜技術
	ZV 3F-1C306	80		9.2 微粒子・粉体 9.5 新機能材料・新物性	「衝撃応用研究グループ企画「科学技術としての衝撃応用とその拡がり」			「重力場応用研究グループ企画「重力場応用研究」		
	ZW 3F-1C310	120		5.2 光記録	3.7 生体・医用光学 (ショート口頭講演)	「機能性酸化物研究グループ企画「機能性酸化物におけるナノ構造制御と機能相関」	3.7 生体・医用光学 (ショート口頭講演)	8.4 プラズマエッチング	8.4 プラズマエッチング	
	ZX 4F-1C403	90	8.2 プラズマ診断・計測	8.2 プラズマ診断・計測	3.5 情報光学	3.5 情報光学	3.2 材料光学	3.2 材料光学		
1H棟	TA 1F-1H101	350	合同セッション F「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッション F「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッション F「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッション F「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッション F「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッション F「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッション F「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッション F「カーボンナノチューブの基礎と応用」
	TB 2F-1H201	350	12.9 有機トランジスタ	「薄膜トランジスタ最前線 シリコン・酸化物半導体・有機半導体の徹底比較」	「産業化に向かう集積化 MEMS 技術の先端開発動向」		10.2 スピンデバイス・回路・計測技術	10.2 スピンデバイス・回路・計測技術	10.2 スピンデバイス・回路・計測技術	10.2 スピンデバイス・回路・計測技術
1E棟	TC 1F-1E102	108	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜		
	TD 2F-1E203	100		「新画像システム研究会企画「複眼光学システムとその工学的応用」	6.5 表面物理・真空	「薄膜・表面物理分科会企画「機能元素のナノ材料科学と材料イノベーション」	6.5 表面物理・真空	6.5 表面物理・真空	6.5 表面物理・真空	
	TE 3F-1E303	94	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡	3.9 光学新領域		
	TF 4F-1E401	104	16.2 プロセス技術	16.2 プロセス技術 16.3 デバイス	16.1 基礎物性・評価	16.1 基礎物性・評価	16.1 基礎物性・評価			
大学会館	TG A棟 3F-ホール	500	スクール「液相成長に学ぶ結晶成長技術の最前線」		「日本学術振興会第 145 委員会・第 161 委員会・第 175 委員会、結晶工学分科会合同企画「次世代結晶系太陽電池における革新的科学技術」		14.4 超高速・機能デバイス	「SiC 及び関連ワイドギャップ半導体研究会企画「低炭素・脱石油社会実現に貢献する SiC パワーデバイス開発の現状」		
	TH C棟 3F-国際会議室	160	講演奨励賞贈呈式	評議員会/業績賞・研究分野業績賞授賞式	「光科学の未来を拓く -Frontier and New Prospects in Optical Science-」		「光科学の未来を拓く -Frontier and New Prospects in Optical Science-」			
第 1 体育館	ポスターセッション P1 ~ P19		6.3 酸化物エレクトロニクス 9.1 誘電材料・誘電体 11.4 アナログ応用および関連技術 14.5 半導体光物性・光デバイス	<前半> 4.5 テラヘルツ全般・非線形光学 10.1 新物質創生・物性探索 12.3 電子機能材料・デバイス <後半> 2.2 精密計測・ナノ計測 4.5 テラヘルツ全般・非線形光学 15.4 III-V 族窒化物結晶	4.5 テラヘルツ全般・非線形光学 6.3 酸化物エレクトロニクス <後半> 14.5 半導体光物性・光デバイス 17.2 教育	<前半> 3.7 生体・医用光学 4.5 テラヘルツ全般・非線形光学 12.9 有機トランジスタ 14.5 半導体光物性・光デバイス <後半> 8.3 プラズマ成膜・表面処理 12.3 電子機能材料・デバイス 15.4 III-V 族窒化物結晶	6.3 酸化物エレクトロニクス 13.1 基礎物性・評価 14.5 半導体光物性・光デバイス	<前半> 3.7 生体・医用光学 7.7 微小電子源 10.1 新物質創生・物性探索 <後半> 12.3 電子機能材料・デバイス 15.4 III-V 族窒化物結晶	5.4 光ファイバー 6.3 酸化物エレクトロニクス 13.1 基礎物性・評価 14.5 半導体光物性・光デバイス	